






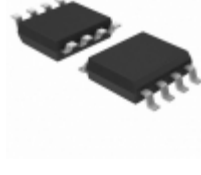

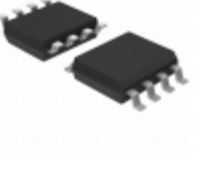
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI4442DY-T1-GE3</p>
	<p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 15A 8-SOIC</p>
	<p>Datenblätter:  SI4442DY-T1-GE3.pdf</p>
<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
<p>Lieferung von: Hong Kong</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI4442DY-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 15A 8-SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±12V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	4.5 mOhm @ 22A, 10V
Verlustleistung (max)	1.6W (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	33 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	50nC @ 4.5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	2.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 15A (Ta) 1.6W (Ta) Surface Mount 8-SO
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	15A (Ta)

SI4442DY-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI4442DY-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI4442DY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ SI4442DY-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI4442DY-T1-E3, VISHAY SI4442DY-T1-E3, VISHAY</p>	 <p>SI4442DY-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 15A 8-SOIC</p>	 <p>SI4446DY-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 40V 3.9A 8-SOIC</p>	 <p>SI4446DY-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 40V 3.9A 8-SOIC</p>
 <p>SI4444-BX-FM-01A SILICON SILICON QFN</p>	 <p>SI4446DY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 40V 3.9A 8-SOIC</p>	 <p>SI4442DY-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 15A 8-SOIC</p>	 <p>SI4442DY-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 15A 8-SOIC</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SI4442DY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SI4442DY-T1-GE3 Datenblatt	SI4442DY-T1-GE3-Datenblätter	SI4442DY-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI4442DY-T1-GE3
SI4442DY-T1-GE3 Electronic	SI4442DY-T1-GE3-Komponenten	SI4442DY-T1-GE3-Verteiler	SI4442DY-T1-GE3-Bild	SI4442DY-T1-GE3-Teil
SI4442DY-T1-GE3 Preis	SI4442DY-T1-GE3 Hersteller	SI4442DY-T1-GE3 Bild	SI4442DY-T1-GE3 Aktie	SI4442DY-T1-GE3 Inventar
SI4442DY-T1-GE3 Neu	SI4442DY-T1-GE3 Original	SI4442DY-T1-GE3 garantiert	SI4442DY-T1-GE3 RFQ	SI4442DY-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited